CLIPPEDIMAGE= JP410294177A

PAT-NO: JP410294177A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10294177 A

TITLE: ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

PUBN-DATE: November 4, 1998

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

NAKATSUKA, MASAKATSU

KITAMOTO, NORIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUI CHEM INC

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP09100209

APPL-DATE: April 17, 1997

INT-CL (IPC): H05B033/14; C09K011/06; H05B033/22

### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic

electroluminescence element which

is excellent in light emitting efficiency and is excellent in light emitting

luminance by sandwiching at least a single layer of this light emitting layer

by forming a layer containing at least one kind of naphthofluoranthene

derivative between a pair of electrodes as the light emitting layer.

SOLUTION: A naphthofluoranthene derivative used here is formed by annularly

contracting a fluoranthene skeleton and a single naphthalene ring, and is a

compound expressed by formulas I to IV. In the formulas, X < SB > 1 < /SB > to

X<SB>14</SB> are hydrogen, halogen, an alkoxy group and an aryl group, and

X < SB > 7 < /SB >, X < SB > 13 < /SB > and X < SB > 14 < /SB > are a

substitutional or

nonsubstitutional aryl group having the carbon number of 6 to 16, and the other

03/14/2002, EAST Version: 1.03.0002

is a compound being a hydrogen atom. An organic electroluminescence element is normally formed by sandwiching at least a single layer of a light emitting layer containing at least one kind of light emitting component between a pair of electrodes, and a naphthofluoranthene derivative of a light emitting organic metallic complex is contained in this light emitting layer.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-294177

(43)公開日 平成10年(1998)11月4日

(51) Int.Cl.6	敝	別記号	FΙ		
H05B	33/14		H05B	33/14	
C09K	11/06		C09K	11/06	Z
H05B	33/22		H 0 5 B	33/22	

#### 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 13 頁)

		青玉明小 小明小 明小人の悪い しこ (王 10 月
(21)出願番号	特顧平9-100209	(71)出願人 000005887 三井化学株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)4月17日	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
		(72)発明者 中塚 正勝 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三 東圧化学株式会社内
		(72)発明者 北本 典子 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三 東圧化学株式会社内

# (54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

## (57)【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、ナフトフルオランテン 誘導体を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層 挟持してなる有機電界発光素子。

【効果】 発光輝度が優れた有機電界発光素子を提供する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、ナフトフルオランテン 誘導体を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層 挟持してなる有機電界発光素子。

【請求項2】 ナフトフルオランテン誘導体を含有する 層が発光層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 ナフトフルオランテン誘導体を含有する層が、発光性有機金属錯体を含有することを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送 10 層を有する請求項1~3のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送 層を有する請求項1~4のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【請求項6】 ナフトフルオランテン誘導体が、ナフト [2,3-b] フルオランテン誘導体、ナフト[1,2-k] フルオランテン誘導体、ナフト[2,3-j] フルオランテン誘導体 またはナフト[2,3-k] フルオランテン誘導体である請求 項1~5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バ ックライトなどのパネル型光源として使用されてきた が、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要 である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機 電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有 30 機Eし素子)が開発された [Appl. Phys. Lett., 51] 913 (1987)〕。有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物 を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、 該薄膜に電子および正孔 (ホール)を注入して、再結合 させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、こ の励起子が失活する際に放出される光を利用して発光す る素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度 の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機 化合物の種類を選択することにより、種々の色(例え ば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このよう 40 な特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、 表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、 一般に、発光輝度が低く、実用上充分ではない。

(4-フェニルフェノラート)アルミニウムをホスト化合物、蛍光性化合物として、アクリドン誘導体(例えば、N-メチル-2-メトキシアクリドン)をゲスト化合物として用いた有機電界発光素子が提案されている(特開平8-67873号公報)。しかしながら、これらの発光素子も充分な発光輝度を有しているとは言い難い。現在では、一層高輝度に発光する有機電界発光素子が望まれている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供 することである。

### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界 発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成する に至った。すなわち、本発明は、

●一対の電極間に、ナフトフルオランテン誘導体を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

20 **②**ナフトフルオランテン誘導体を含有する層が、発光層 である**①**記載の有機電界発光素子、

③ナフトフルオランテン誘導体を層が、発光性有機金属 錯体を含有することを特徴とする①または②記載の有機 電界発光素子、

④一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前記記○○③のいずれかに記載の有機電界発光素子、

⑤一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記のへのいずれかに記載の有機電界発光素子、

⑥ナフトフルオランテン誘導体が、ナフトフルオランテン誘導体が、ナフト[2,3-b] フルオランテン誘導体、ナフト[1,2-k] フルオランテン誘導体、ナフト[2,3-j] フルオランテン誘導体またはナフト[2,3-k] フルオランテン誘導体である前記②~⑤のいずれかに記載の有機電界発光素子、に関するものである。

#### [0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、ナフトフルオランテン誘導体を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなるものである。本発明で用いるナフトフルオランテン誘導体(以下、本発明に係る化合物Aと略記する)は、フルオランテン骨格と1個のナフタレン環が縮環したものであり、好ましくは、ナフト[2,3-b] フルオランテン誘導体、ナフト[1,2-k] フルオランテン誘導体、ナフト[2,3-j] フルオランテン誘導体である。ナフト[2,3-b] フルオランテン誘導体、ナフト[1,2-k] フルオランテン誘導体、ナフト[1,2-k] フルオランテン誘導体、ナフト[1,2-k] フルオランテン誘導体、ナフト[1,2-k] フルオランテン誘導体、ナフト[2,3-j] フルオランテン誘導体としては、好ましくは、それぞれ、一般式(1)、一般式(2) 一般式(3)まなけ一般式(1)、一般式(2) 一般式(3)まなけ一般式(1)、一般式(2) 一般式(3)まなけ一般式(4)(41)で

表される化合物である。 [0007]

\*【化1】

$$X_{10}$$

$$X_{10}$$

$$X_{10}$$

$$X_{12}$$

$$X_{12}$$

$$X_{13}$$

$$X_{14}$$

$$X_{2}$$

$$X_{2}$$

$$X_{3}$$

$$X_{4}$$

$$X_{5}$$

$$X_{5}$$

$$X_{15}$$

$$X_{16}$$

$$X_{18}$$

$$X_{19}$$

$$X_{11}$$
 $X_{12}$ 
 $X_{14}$ 
 $X_{14}$ 
 $X_{15}$ 
 $X_{14}$ 
 $X_{15}$ 
 $X_{14}$ 
 $X_{15}$ 
 $X$ 

$$X_{10}$$
 $X_{10}$ 
 $X_{11}$ 
 $X_{12}$ 
 $X_{13}$ 
 $X_{14}$ 
 $X_{15}$ 
 $X_{14}$ 
 $X_{15}$ 
 $X$ 

$$X_{12} X_{13} X_{14} X_{2}$$
 $X_{14} X_{2} X_{3} X_{4}$ 
 $X_{14} X_{2} X_{4} X_{5}$ 
 $X_{15} X_{14} X_{2} X_{5}$ 
 $X_{15} X_{15} X_{15} X_{15}$ 
 $X_{15} X_{15} X_{15} X_{15}$ 

(式中、 $X_1 \sim X_{14}$ はそれぞれ水素原子、ハロゲン原 子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐ま たは環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換の アリール基を表す)

【0008】一般式(1)~一般式(4)で表される化 合物において、 $X_1 \sim X_{14}$ は水素原子、ハロゲン原子、 直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または 環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリ ール基を表し、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子 (例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子)、炭素数 1~10の直鎖、分岐または環状のアルキル基(例え ば、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピ ル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、 n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、te rtーペンチル基、n-ヘキシル基、シクロヘキシル基、

※ル基、tert-オクチル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、n-デシル基など)、炭素数1~10の直 鎖、分岐または環状のアルコキシ基(例えば、メトキシ 基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ 基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec -ブトキシ 40 基、n-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、n -ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、n-ヘ プチルオキシ基、n-オクチルオキシ基、2-エチルへ キシルオキシ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキ シ基など)、あるいは炭素数6~16の置換または未置 換のアリール基(例えば、フェニル基、2-メチルフェ ニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル 基、4-エチルフェニル基、4-n-プロピルフェニル 基、4-イソプロピルフェニル基、4-n-ブチルフェ ニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4-イソペンチ n-ヘプチル基、シクロヘキシルメチル基、n-オクチ※50 ルフェニル基、4-tert-ペンチルフェニル基、4-n

-ヘキシルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル 基、4-n-オクチルフェニル基、4-n-デシルフェ ニル基、2、4-ジメチルフェニル基、3、4-ジメチ ルフェニル基、2-メトキシフェニル基、4-メトキシ フェニル基、3-エトキシフェニル基、4-エトキシフ ェニル基、4-n-プロポキシフェニル基、3-イソプ ロポキシフェニル基、4-n-ブトキシフェニル基、4 - n - ペンチルオキシフェニル基、4 - シクロヘキシル オキシフェニル基、4-n-ヘプチルオキシフェニル 基、4-n-オクチルオキシフェニル基、4-n-デシ 10 ルオキシフェニル基、3,4-ジメトキシフェニル基、 3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、2 - クロロフェニル基、4 - クロロフェニル基、2 - メチ ルー4-クロロフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフ チル基など)であり、より好ましくは、水素原子、フッ 素原子、塩素原子、炭素数1~6のアルキル基、炭素数 1~6のアルコキシ基または炭素数6~10のアリール 基であり、特に好ましくは、水素原子または炭素数6~ 10のアリール基である。

【0009】本発明に係る化合物Aとしては、一般式 (1) においては $X_1 \sim X_{14}$ が水素原子である化合物、 一般式(2)においては $X_1 \sim X_{14}$ が水素原子である化 合物、一般式(3)においては $X_1 \sim X_{14}$ が水素原子で ある化合物が、特に好ましい。また、一般式(4)にお いては $X_1 \sim X_{14}$ が水素原子である化合物、 $X_7$  および X14が炭素数6~10の置換または未置換のアリール基 であり、且つその他が水素原子である化合物、X7 、X 13およびX14が炭素数6~10の置換または未置換のア リール基であり、且つその他が水素原子である化合物が 特に好ましい。

【0010】本発明に係る化合物Aの具体例としては、 例えば、以下の化合物を挙げることができるが、本発明 はこれらに限定されるものではない。

### ・例示化合物

## 番号

- 1. ナフト[2,3-b] フルオランテン
- 2. 3-n-ブチルナフト[2,3-b] フルオランテン
- 6-メトキシナフト[2,3-b] フルオランテン 3.
- 7-クロロナフト[2,3-b] フルオランテン
- 5. 5-(4'-メトキシフェニル)ナフト[2,3-b] フルオランテン
- 6. ナフト[1, 2-k]フルオランテン
- 10-n-ヘキシルオキシナフト[1, 2-k]フルオ 8. ランテン
- 9. 8-フルオロナフト[1, 2-k]フルオランテン
- 10. 11-フェニルナフト(1, 2-k)フルオランテン
- 11. ナフト[2, 3-j]フルオランテン
- 12. 1 - n - ペンチルナフト[2, 3-j]フルオランテ

- 13. 2-メトキシナフト[2, 3-j]フルオランテン
- 7-クロロナフト[2, 3-j]フルオランテン 14.
- 15. 8-(1'-ナフチル)ナフト[2, 3-j]フルオ ランテン
- 16. ナフト[2, 3-k]フルオランテン
- 17. 10-メチルナフト[2, 3-k]フルオランテン
- 18. 8-メトキシナフト[2, 3-k]フルオランテン
- 19. 8-フルオロナフト[2, 3-k]フルオランテン
- 20. 8,13-ジクロロナフト[2,3-k]フルオラン テン

#### [0011]

- 21. 7-フェニルナフト[2, 3-k]フルオランテン
- 7,14-ジフェニルナフト[2,3-k]フルオラ 22. ンテン
- 23. 7, 14-ジ(4'-メチルフェニル) ナフト [2, 3-k] ブルオランテン
- 24. 7, 14-ジ(3'-メチルフェニル) ナフト [2. 3-k]フルオランテン
- 25. 7, 14-ジ(4'-エチルフェニル) ナフト
- 20 [2, 3-k]フルオランテン
  - 26. 7, 14-ジ(4'-tert-ブチルフェニル) ナフト[2, 3-k]フルオランテン
  - 27. 7, 14-ジ(4'-メトキシフェニル)ナフ ト[2, 3-k]フルオランテン
  - 28. 7, 14-ジ(3'-エトキシフェニル)ナフ ト[2, 3-k]フルオランテン
  - 29. 7, 14-ジ(3'-フルオロフェニル)ナフ ト[2, 3-k]フルオランテン
  - 30. 7, 14-i(4'-2)
- 30 [2, 3-k]フルオランテン
  - 31. 7,14-ジ(2'-ナフチル)ナフト[2,3k]フルオランテン
  - 32. 7, 13, 14-トリフェニルナフト[2, 3-k] フルオランテン
  - 33. 7,8,13,14-テトラフェニルナフト [2, 3-k]フルオランテン
  - 【0012】本発明に係る化合物Aは、其自体公知の方 法に従って製造することができる。例えば、Synthesis, 497 (1983) 、J. Org. Chem., <u>17</u>、845 (1952)に記載
- 40 の方法に従って製造することができる。すなわち、例え ば、ナフト[1, 2-k]フルオランテン誘導体およびナフト [2, 3-k]フルオランテン誘導体は、アセナフテンキノン 誘導体と、1,2-ビス(トリフェニルフォスフォニウ ムメチル)ナフタレンジブロミド誘導体または2,3-ビス (トリフェニルフォスフォニウムメチル) ナフタレ ンジブロミド誘導体を、塩基の存在下で反応(Wittig反 応) させることにより製造することができる。
  - 【0013】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間 に、少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を少な
- 50 くとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する

化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子 輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入 輸送成分を含有する正孔注入輸送層または/および電子 注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることも できる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機 能、正孔輸送機能または/および電子注入機能、電子輸 送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層また は/および電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とす ることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送 層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子 10 (一層型の素子)の構成とすることもできる。また、正 孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれ の層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、 正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層 において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を 別々に設けて構成することもできる。

【0014】本発明の有機電界発光素子において、本発 明に係る化合物Aは、正孔注入輸送成分、発光成分また は電子注入輸送成分に用いることが好ましく、正孔注入 輸送成分または発光成分に用いることがより好ましく、 発光成分に用いることが特に好ましい。本発明の有機電 界発光素子においては、本発明に係る化合物Aは、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0015】本発明の有機電界発光素子の構成として は、特に限定するものではなく、例えば、(A) 陽極/ 正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子 (図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極 型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層 /陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素 子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光 30 層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E) 陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子 注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。

(D)型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一 対の電極間に挟持させた型の素子は勿論であるが、さら には、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分およ び電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送 成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図7)、または(H)発光成 40 分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対 の電極間に挟持させた型の素子(図8)がある。

【0016】本発明の有機電界発光素子は、これらの素 子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子におい て、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層 設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子 において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入 輸送成分と発光成分の混合層または/および発光層と電 子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の 混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発 50 導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラ

光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C) 型素子、(E)型素子、(F)型素子、(G)型素子ま たは(H)型素子であり、さらに好ましくは、(A)型

素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子また は(H)型素子であり、特に好ましくは、(A)型素

子、(B)型素子、(C)型素子または(F)型素子で ある。

【0017】本発明の有機電界発光素子について、例え ば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光 層/電子注入輸送層/陰極型素子を基に説明する。(図 1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送 層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は 電源を示す。

【0018】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支 持されていることが好ましく、基板としては、特に限定 するものではないが、透明ないし半透明であることが好 ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート (例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスル フォン、ポリメチルメタアクリレート、ポリプロピレ ン、ポリエチレンなどのシート)、半透明プラスチック シート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み 合わせた複合シートからなるものを挙げることができ る。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色 変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコント ロールすることもできる。

【0019】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陽極に使用する電極物質として は、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、 パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化 亜鉛、ITO(インジウム・ティン・オキサイド)、ポ リチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができ る。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、ある いは複数併用してもよい。陽極は、これらの電極物質 を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法によ り、基板の上に形成することができる。また、陽極は一 層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよ い。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/□ 以下、より好ましくは、5~50 Ω/□程度に設定す る。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよる が、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、 10~500nm程度に設定する。

【0020】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホ ール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔 を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正 孔注入輸送層は、本発明に係る化合物Aおよび/または 他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロ シアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリ ールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘

ン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、 ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカ ルバゾール誘導体など)を少なくとも1種用いて形成す ることができる。尚、正孔注入輸送機能を有する化合物 は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよ 11

【0021】本発明において用いる他の正孔注入輸送機 能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体 (例えば、4,4'-ビス [N-フェニル-N-(4" ーメチルフェニル) アミノ) ビフェニル、4,4'ービ 10 ス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ **丿〕ビフェニル、4,4'-ビス〔N-フェニルーN-**(3"-メトキシフェニル)アミノ〕ビフェニル、4, 4'-ビス(N-フェニル-N-(1"-ナフチル)ア ミノ) ビフェニル、3,3'ージメチルー4,4'ービ ス〔N-フェニルーN-(3"-メチルフェニル)アミ ノ〕ビフェニル、1,1-ビス〔4'-[N,N-ジ (4"-メチルフェニル)アミノ]フェニル]シクロへ キサン、9,10-ビス[N-(4'-メチルフェニ (N) - N - (4" - n - ブチルフェニル) アミノ ] フェ 20ナントレン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミ ノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルー N, N-ビス(4", 4"'-ビス(N', N'-ジ(4 ーメチルフェニル) アミノ] ピフェニルー4ーイル) ア ニリン、4,4',4"-トリス[N-(3"'-メチル フェニル) - N - フェニルアミノ〕 トリフェニルアミン など)、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーN-ビニルカルバゾール誘導体がより好ましい。本発明に係 る化合物Aと他の正孔注入輸送機能を有する化合物を併 用する場合、正孔注入輸送層中に占める本発明に係る化 30 合物Aの割合は、好ましくは、0.1~40重量%程度 に調製する。

【0022】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発 光層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の発光 機能を有する蛍光性化合物(例えば、アクリドン誘導 体、キナクリドン誘導体、多環芳香族化合物〔例えば、 ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレ ン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラフェニ ルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジ エン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス (フェニルエチニル) アントラセン、1,4-ビス (9'-エチニルアントラセニル)ベンゼン、4,4' ービス(9"ーエチニルアントラセニル)ビフェニ ル〕、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノリノラ ート) アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h] キノリノ ラート) ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシフェニ ル)ベンゾオキサゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロ キシフェニル) ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロ 50 錯体としては、例えば、一般式 (a) ~一般式 (c) で

10

キシアクリジンの亜鉛塩〕、スチルベン誘導体〔例え ば、1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジ エン、4、4'ービス(2、2ージフェニルビニル)ビ フェニル〕、クマリン誘導体〔例えば、クマリン1、ク マリン6、クマリン7、クマリン30、クマリン10 6、クマリン138、クマリン151、クマリン15 2、 クマリン153、 クマリン307、 クマリン31 1、クマリン314、クマリン334、クマリン33 8、クマリン343、クマリン500〕、ピラン誘導体 〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘導体 [例えば、ナイルレッド]、ベンゾチアゾール誘導体、 ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導 体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリー Nービニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフ ェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導 体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレン ビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレン およびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンおよび その誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導 体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体など)を 少なくとも1種用いて形成することができる。

【0023】本発明の有機電界発光素子においては、発 光層に本発明に係る化合物Aを含有していることが好ま しい。本発明に係る化合物Aと他の発光機能を有する化 合物を併用する場合、発光層中に占める本発明に係る化 合物Aの割合は、好ましくは、0.001~99.99 9重量%程度、より好ましくは、0.01~99.99 重量%程度、さらに好ましくは、0.1~99.9重量 %程度に調製する。

【0024】本発明において用いる他の発光機能を有す る化合物としては、発光性有機金属錯体がより好まし い。例えば、J. Appl. Phys., 65、3610 (1989) 、特開 平5-214332号公報に記載のように、発光層をホ スト化合物とゲスト化合物(ドーパント)とより構成す ることもできる。本発明に係る化合物Aを、ホスト化合 物として用いて発光層を形成することができ、さらに は、ゲスト化合物として用いて発光層を形成することも できる。本発明に係る化合物Aを、ゲスト化合物として 用いて発光層を形成する場合、ホスト化合物としては、 発光性有機金属錯体が好ましい。この場合、発光性有機 金属錯体に対して、本発明に係る化合物Aを、好ましく は、0.001~40重量%程度、より好ましくは、 0.01~30重量%程度、特に好ましくは、0.1~ 10重量%程度使用する。

【0025】本発明に係る化合物Aと併用する発光性有 機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発 光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置 換の8-キノリノラート配位子を有する発光性有機アル ミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性有機金属 表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることがで きる。

$$(Q)_3 - A_1 \qquad (a)$$

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配 位子を表す)

$$(Q)_2 - A_1 - O - L$$
 (b)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、O - Lはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を 含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

$$(Q)_2 - A_1 - O - A_1 - (Q)_2$$
 (c)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す) 【0026】発光性有機金属錯体の具体例としては、例 えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ト リス(4-メチル-8-キノリノラート)アルミニウ ム、トリス (5-メチル-8-キノリノラート) アルミ ニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラー ト)アルミニウム、トリス(4,5-ジメチル-8-キ ノリノラート) アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ ルー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メ チル-8-キノリノラート)(フェノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル -8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、 【0027】ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 30 -メチル-8-キノリノラート)(2,3-ジメチルフ ェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キ ノリノラート)(2,6-ジメチルフェノラート)アル ミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (3,4-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチ ルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート) (3,5-ジーtertーブチルフェノ ラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリ ノラート)(2,6-ジフェニルフェノラート)アルミ 40 ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2,4,6-トリフェニルフェノラート) アルミニウ ム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2, 4,6-トリメチルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,5,6 ーテトラメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2

-メチル-8-キノリノラート)(1-ナフトラート)

ト)(2-ナフトラート)アルミニウム、ビス(2,4

アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラー

12

**ノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8** ーキノリノラート) (3-フェニルフェノラート) アル ミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラー **ト) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス** (2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチルー8ーキノリノラート)(3,5ージーtertー ブチルフェノラート) アルミニウム、

【0028】ビス(2-メチル-8-キノリノラート) 10 アルミニウムールーオキソービス(2-メチルー8ーキ ノリノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル **-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソービ** ス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラ ート) アルミニウムーμーオキソービス (2-メチルー 4-エチル-8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2-x+y-4-x++y-8-+y)ルミニウムーμーオキソービス(2-メチルー4-メト キシ-8-キノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メチルー5ーシアノー8ーキノリノラート) アルミニウ ムールーオキソービス(2-メチルー5-シアノー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-5 ートリフルオロメチル-8-キノリノラート) アルミニ ウム-μ-オキソービス(2-メチル-5-トリフルオ ロメチルー8-キノリノラート) アルミニウムなどを挙 げることができる。勿論、発光性有機金属錯体は、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0029】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注 入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する 機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送 層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の電子注 入輸送機能を有する化合物(例えば、有機金属錯体〔例 えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ビ ス(10-ベンゾ(h) キノリノラート) ベリリウム〕、 オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、トリア ジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、キノキ サリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フ ルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体な ど)を少なくとも1種用いて形成することができる。本 発明に係る化合物Aと他の電子注入輸送機能を有する化 合物を併用する場合、電子注入輸送層中に占める本発明 に係る化合物Aの割合は、好ましくは、0.1~40重 量%程度に調製する。本発明においては、本発明に係る 化合物Aと有機金属錯体〔例えば、前記一般式(a)~ 一般式(c)で表される化合物〕を併用して、電子注入 輸送層を形成することは好ましい。

【0030】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陰極に使用する電極物質として ージメチルー8ーキノリノラート)(2ーフェニルフェ 50 は、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナ

トリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マグネシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウムーフチウム合金、アルミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0031】陰極は、これらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗は、数百Ω/□以下に設定するのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000 nm程度、より好ましくは、10~500 nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光 20光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0032】また、本発明の有機電界発光素子において は、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャー が含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとし ては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、 ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げ られ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素ク エンチャーが含有されている層としては、特に限定する ものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸 送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。 尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャー を含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させ てもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光 層、発光機能を有する電子注入輸送層) の近傍に含有さ せてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0033】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例えば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブロゼット法など)により薄膜を形成することにより作製することができる。真空蒸着法により、各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、10-5Torr程度以下の真空下で、50~400℃程度のボート温度(蒸着源温度)、-50~300℃程度の基50

14

板温度で、0.005~50nm/sec 程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電界発光素子を製造することができる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御して、共蒸着することが好ましい。

【0034】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正 孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用し うるバインダー樹脂としては、例えば、ポリーNービニ ルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリ エステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、 ポリメチルメタアクリレート、ポリエーテル、ポリカー ボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミ ド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレン オキサイド、ポリエーテルスルフォン、ポリアニリンお よびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポ リフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレ ンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびそ の誘導体等の高分子化合物が挙げられる。バインダー樹 脂は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用しても よい。

【0035】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、 デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メ チルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメ タン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエ タン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロ ゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノー ル、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサ ノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチ ルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶 媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、 ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶媒、例えば、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、1ーメチルー2ーピロリドン、1,3ージメ チル-2-イミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイ ド等の極性溶媒) および/または水に溶解、または分散 させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成す ることができる。

0 【0036】尚、分散する方法としては、特に限定する

ものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設定することができ、一般には、0.1~50重量%程度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度である。尚、バインダー樹脂を使用する場合、その使用量に関しては、特に限定するものではないが、一般には、各層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場別の会には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量%程度、好ましくは、15~90重量%程度に設定する。

【0037】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般 に、5nm~5µm程度に設定することが好ましい。 尚、作製した素子に対し、酸素や水分等との接触を防止 する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また素子 を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオ イル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカ ーボン油などの不活性物質中に封入して保護することが できる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機 高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、シ リコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレ ン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポ リイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリ エチレン、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例 えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶 縁性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、 金属硫化物)、さらには光硬化性樹脂などを挙げること ができ、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよ く、あるいは複数併用してもよい。保護層は、一層構造 であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0038】また、電極に保護膜として、例えば、金属酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層)を設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0039】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型または交流駆動型の素子としても使用することができる。 尚、印加電圧は、一般に、2~30V程度である。本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

# [0040]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説 50 メトキシアクリドンを使用した以外は、実施例1に記載

16

明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものではない。

#### 【0041】実施例1

厚さ200 nmの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、IT〇透明電極上に、4,4'ービス〔Nーフェ ニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ〕ビフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフ ェノラート) アルミニウムとナフト[2.3-b] フルオラン テン (例示化合物番号1の化合物)を、異なる蒸着源か ら、蒸着速度O.2nm/sec で50nmの厚さに共蒸 着(重量比100:0.5)し、発光層とした。次に、 トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速 度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注 入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀 を、蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共 蒸着(重量比10:1)して、陰極とし、有機電界発光 素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保っ たまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰 囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、55mA /cm² の電流が流れた。輝度2250cd/m² の青 色の発光が確認された。

# 【0042】実施例2~5

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物番号1の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号6の化合物(実施例2)、例示化合物番号16の化合物(実施例3)、例示化合物番号22の化合物(実施例4)、例示化合物番号32の化合物(実施例5)を使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表に示した。【0043】比較例1

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物番号1の化合物を使用せずに、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(4ーフェニルフェノラート)アルミニウムだけを用いて、50nmの厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表に示した。【0044】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物番号1の化合物を使用する代わりに、N-メチル-2-メトキシアクリドンを使用した以外は、実施例1に記載

の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子 に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したとこ ろ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、\*

\*結果を第1表に示した。 【0045】 【表1】 第1表

有機電界 発光素子	輝度 (c d/m²)	電流密度 (mA/cm²)
実施例2	2 2 8 0	5.5
実施例3	2300	5 4
実施例4	2320	5 3
実施例 5	2260	5 6
比較例1	1170	8 2
比較例2	1550	74

#### 【0046】実施例6

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ 20 らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10<sup>-6</sup> Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、4,4'ービス(Nーフェ ニルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ] ピフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと例示化合物番号24の化合 物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で 50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0)し、 発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)ア ルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの 厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上 に、マグネシウムと銀を、蒸着速度O.2nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して、陰 極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸 着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電 界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加 したところ、58mA/cm²の電流が流れた。輝度2 270 c d/m² の青色の発光が確認された。

### 【0047】実施例7

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、4,4'\*-ビス(N-フェ ニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ) ビフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸

※(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ -オキソービス(2-メチル-8-キノリノラート)ア ルミニウムと例示化合物番号23の化合物を、異なる蒸 着源から、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さ に共蒸着(重量比100:2.0)し、発光層とした。 次に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを、 蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、 電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウム と銀を、蒸着速度O. 2nm/sec で200nmの厚さ に共蒸着(重量比10:1)して、陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を 保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾 燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、57 mA/cm<sup>2</sup> の電流が流れた。輝度2180 cd/m<sup>2</sup> の青色の発光が確認された。

# 【0048】実施例8

厚さ200 nmの ITO透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、IT〇透明電極上に、4,4'ービス〔Nーフェ ニルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ〕 ビフェニ 40 ルを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウ ムーμーオキソービス(2,4-ジメチルー8-キノリ ノラート)アルミニウムと例示化合物番号32の化合物 を、異なる蒸着源から、蒸着速度O.2nm/sec で5 0 n mの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、発 光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アル ミニウムを、蒸着速度O.2nm/sec で50nmの厚 さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス※50 マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で20

Onmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して、陰極と し、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽 の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加した ところ、60mA/cm<sup>2</sup> の電流が流れた。輝度215 Ocd/m²の青色の発光が確認された。

### 【0049】実施例9

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ 10 らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、4,4'ービス〔Nーフェ ニルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリ ス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番 号11の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100: 1.0)し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さ らにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2n m/sec で200 n mの厚さに共蒸着(重量比10: 1)して、陰極とし、有機電界発光素子を作製した。 尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。 作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの 直流電圧を印加したところ、58mA/cm2の電流が 流れた。輝度2070 c d/m²の緑色の発光が確認さ れた。

#### 【0050】実施例10

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、4,4'ービス[N-フェ ニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ] ビフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、例示 化合物番号25の化合物を、蒸着速度0.2nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、そ の上に、1,3-ビス(5'-(p-tert-ブチルフェ ニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル] ベンゼンを、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚 さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、 マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で20 0 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して、陰極と し、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽 の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加した

20

Ocd/m²の青色の発光が確認された。 【0051】実施例11

厚さ200 n mの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、例示化合物番号27の化合 物を、蒸着速度0.2nm/sec で55nmの厚さに蒸 着し、発光層とした。次いで、その上に、1,3-ビス (5' - (p - tert - ) + ) - 1, 3, 4 -オキサジアゾールー2′ーイル〕ベンゼンを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nmの厚さに蒸着し、電子注入 輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、 蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1)して、陰極とし、有機電界発光素子 を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったま ま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気 下、15Vの直流電圧を印加したところ、68mA/c m²の電流が流れた。輝度1230cd/m²の青色の 発光が確認された。

#### 【0052】実施例12

厚さ200 nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリーNービニルカルバゾール(重量平均分子量1 50000)、例示化合物28の化合物、クマリン 6["3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチル 30 アミノクマリン" (緑色の発光成分)〕、およびDCM 1〔"4-(ジシアノメチレン)-2-メチル-6-(4'-ジメチルアミノスチリル)-4H-ピラン" (オレンジ色の発光成分)〕を、それぞれ重量比10 0:5:3:2の割合で含有する3重量%ジクロロエタ ン溶液を用いて、ディップコート法により、400nm の発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス 基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽 を3×10<sup>-6</sup> Torr に減圧した。さらに、発光層の上 に、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4-フェニ ルーーラー (4"ービフェニル)ー1,2,4ートリア ゾールを、蒸着速度0.2nm/sec で20nmの厚さ に蒸着した後、さらにその上に、トリス(8-キノリノ ラート) アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で 30 n mの厚さに蒸着し電子注入輸送層とした。さらに その上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/ sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し て、陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着 は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した 有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧 ところ、48mA/cm² の電流が流れた。輝度187 50 を印加したところ、74mA/cm² の電流が流れた。

輝度1080cd/m²の白色の発光が確認された。 【0053】実施例13

厚さ200mmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリーNービニルカルバゾール(重量平均分子量1 50000)、1, 3-ビス〔5'-(p-tert-ブチ  $\mu$ フェニル) -1, 3, 4 - オキサジアゾール-2' -イル〕ベンゼンおよび例示化合物番号26の化合物を、 それぞれ重量比100:30:3の割合で含有する3重 量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法に より、300nmの発光層を形成した。次に、この発光 層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固 定した後、蒸着槽を3×10<sup>-6</sup> Torr に減圧した。さら に、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0. 2 n m/sec で 200 n m の 厚 さ に 共蒸着 (重量比 1 0:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。 作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの 直流電圧を印加したところ、76mA/cm²の電流が 20 流れた。輝度1380 c d/m²の青色の発光が確認さ nt.

#### 【0054】比較例3

実施例13において、発光層の形成に際して、例示化合 物番号26の化合物の代わりに、1,1,4,4-テト ラフェニルー1, 3-ブタジエンを使用した以外は、実 施例13に記載の方法により有機電界発光素子を作製し た。作製した有機電界素子に、乾燥雰囲気下、15Vの 直流電圧を印加したところ、86mA/cm²の電流が 流れた。輝度680cd/m²の青色の発光が確認され 30 ある。 た。

# 【0055】実施例14

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、 4, 4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフ ェニル) アミノ〕 ビフェニル、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウムールーオキソービス(2 40 5a:電子注入輸送成分 -メチル-8-キノリノラート) アルミニウムおよび例 示化合物番号32の化合物を、それぞれ重量比100: 40:60:1の割合で含有する3重量%ジクロロエタ

22

ン溶液を用いて、ディップコート法により、300nm の発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス 基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽 を3×10<sup>-6</sup> Torr に減圧した。さらに、発光層の上 に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極 とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界 発光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加し たところ、66mA/cm<sup>2</sup> の電流が流れた。輝度78 Ocd/m²の青色の発光が確認された。

[0056]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電 界発光素子を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例(A)の概略構造図で

【図2】有機電界発光素子の一例(B)の概略構造図で ある。

【図3】有機電界発光素子の一例(C)の概略構造図で ある。

【図4】有機電界発光素子の一例(D)の概略構造図で ある。

【図5】有機電界発光素子の一例(E)の概略構造図で

【図6】有機電界発光素子の一例(F)の概略構造図で

【図7】有機電界発光素子の一例(G)の概略構造図で

【図8】有機電界発光素子の一例(H)の概略構造図で

【符号の説明】

1:基板

2:陽極

3:正孔注入輸送層

3a:正孔注入輸送成分

4:発光層

4 a:発光成分

5:電子注入輸送層

5":電子注入輸送層

6:陰極

7:電源

